

SOFT RECOVERY DIODE MODULE

DBA200WA60

DBA200WA60

《Advantages》

- 2 diodes in 1 isolated package (SOT-227)

- High power, high speed and low loss control
- $I_R \leq 4.0\text{mA}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$
- $V_{FM} \leq 1.5\text{V}$
- $t_{rr} \leq 130\text{ns}$

《特長》

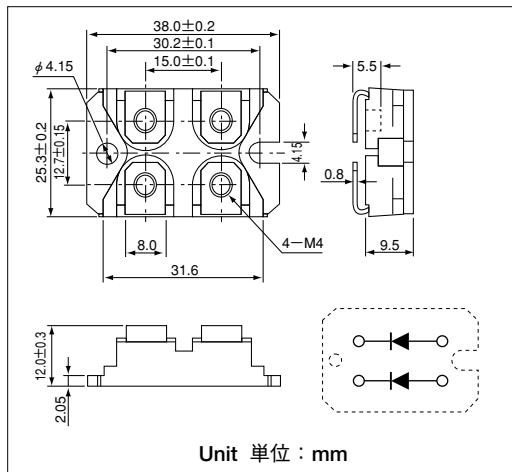
- 大電力2素子入り絶縁型パッケージ (SOT-227)
- 低損失・高速駆動可能
- 低逆電流 $I_R \leq 4.0\text{mA}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$
- 低オン電圧 $V_{FM} \leq 1.5\text{V}$
- 高速ソフトリカバリー $t_{rr} \leq 130\text{ns}$

《Applications》

- Switching power supply, Welding power supply, power source for communication and various power supplies

《用途》

- スイッチング電源、溶接機、通信用電源、各種電源装置



■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise $T_j=25^\circ\text{C}$, per one element / 特にことわらない限り $T_j=25^\circ\text{C}$, 単位エレメント当たり)

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値	Unit 単位
$V_R(\text{DC})$	D.C. Reverse Voltage 直流逆電圧	600	V

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
$I_F(\text{AV})$	Average Forward Current 平均順電流	D.C. $T_c=89^\circ\text{C}$ 直流 ケース温度 89°C	100	A
I_{FSM}	Surge Forward Current サージ順電流	50/60Hz, $\frac{1}{2}\text{cycle}$, Peak value, non-repetitive 50/60Hz, $\frac{1}{2}$ サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	1000/1100	A
I^2t	I^2t 電流二乗時間積	Value for one cycle of surge current 1サイクルサージ順電流に対する値	5050	A^2s
T_j	Junction Temperature 接合温度		-40~+150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature 保存温度		-40~+125	$^\circ\text{C}$
V_{iso}	Isolation Voltage (R.M.S.) 絶縁耐圧 (実効値)	A.C.1minute A.C. 1 分間	2500	V
Mounting torque 締付トルク	Mounting (M4) 取付	Recommended Value 1.0~1.4 推奨値	1.5	$\text{N}\cdot\text{m}$
	Terminal (M4) 端子	Recommended Value 1.0~1.4 推奨値	1.5	
	Mass 質量	Typical value 標準値	30	g

■Electrical Characteristics 電気的特性 (Unless otherwise $T_j=25^\circ\text{C}$, per one element / 特にことわらない限り $T_j=25^\circ\text{C}$, 単位エレメント当たり)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I_R	Reverse Current 逆電流	$V_R=600\text{V}$, $T_j=150^\circ\text{C}$			4	mA
V_{FM}	Forward Voltage Drop 順電圧降下	$I_F=100\text{A}$,		1.25	1.50	V
t_{rr}	Reverse Recovery time 逆回復時間	$I_F=100\text{A}$, $V_R=300\text{V}$, $-\text{di}/\text{dt}=200\text{A}/\mu\text{s}$		100	130	ns
$R_{th(j-c)}$	Thermal Resistance (Junction to case) 熱抵抗 (接合部-ケース間)				0.45	$^\circ\text{C}/\text{W}$

